



Этикетка

КСНЛ.431319.003 ЭТ
Микросхема интегральная 1564АП4ТЭП
Функциональное назначение:

Микросхема 1564АП4ТЭП

Два 4 – х канальных формирователя с 3 – мя состояниями на выходе с прямым и инверсным управлением.

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов
Номера выводов показаны условно
Масса не более 1 г.

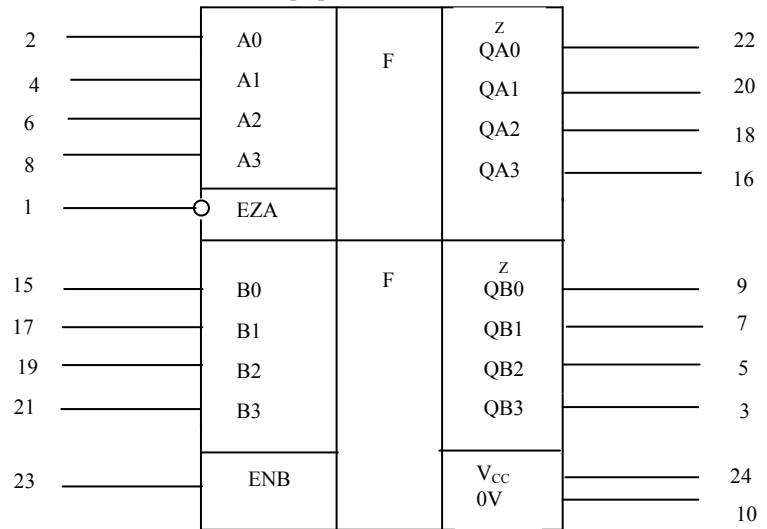
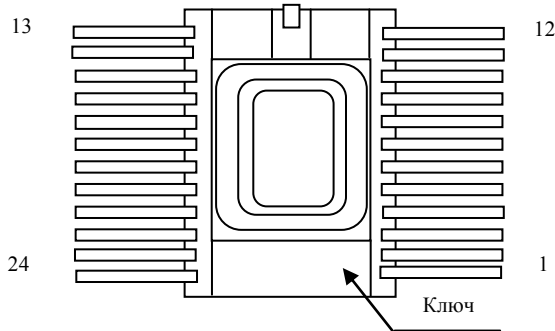


Таблица назначения выводов

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода	№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	EZA	Вход управления	13	NC	Не подключен
2	A0	Вход	14	NC	Не подключен
3	QB3	Выход	15	B0	Вход
4	A1	Вход	16	QA3	Выход
5	QB2	Выход	17	B1	Вход
6	A2	Вход	18	QA2	Выход
7	QB1	Выход	19	B2	Вход
8	A3	Вход	20	QA1	Выход
9	QB0	Выход	21	B3	Вход
10	0V	Общий	22	QA0	Выход
11	NC	Не подключен	23	ENB	Вход управления
12	NC	Не подключен	24	V _{CC}	Питание

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при t = 25±10 °С)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1	2	3	4
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: U _{CC} =2,0 В, U _{IL} =0,3 В, U _{IH} =1,5 В I _O = 20 мкА U _{CC} =4,5 В, U _{IL} =0,9 В, U _{IH} =3,15 В, I _O = 20 мкА U _{CC} =6,0 В, U _{IL} =1,2 В, U _{IH} =4,2 В, I _O = 20 мкА	U _{OL max}	-	0,10
при: U _{CC} =4,5 В, U _{IL} =0,9 В, U _{IH} =3,15 В, I _O = 6,0 мА U _{CC} =6,0 В, U _{IL} =1,2 В, U _{IH} =4,2 В, I _O = 7,8 мА		-	0,10
2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: U _{CC} =2,0 В, U _{IH} =1,5 В, I _O = 20 мкА U _{CC} =4,5 В, U _{IH} =3,15 В, I _O = 20 мкА U _{CC} =6,0 В, U _{IH} =4,2 В, I _O = 20 мкА	U _{OH min}	1,9	-
при: U _{CC} =4,5 В, U _{IH} =3,15 В, I _O = 6,0 мА U _{CC} =6,0 В, U _{IH} =4,2 В, I _O = 7,8 мА		4,4	-
3. Входной ток низкого уровня, мкА, при: U _{CC} = 6,0 В, U _{IL} = 0 В, U _{IH} =U _{CC}	I _{IL}	-	/-0,1/
4. Входной ток высокого уровня, мкА, при: U _{CC} = 6,0 В, U _{IL} = 0 В, U _{IH} =U _{CC}	I _{IH}	-	0,1
5. Ток потребления, мкА, при U _{CC} = 6,0 В, U _{IL} = 0 В, U _{IH} =U _{CC}	I _{CC}	-	4,0
6. Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии «Выключено», мкА, при: U _{CC} =6,0 В, U _{IL} =1,2 В, U _{IH} =4,2 В	I _{OZL} I _{OZH}	-	0,5
7. Динамический ток потребления, мА, при: U _{CC} = 6,0 В, f = 10 МГц U _{EZA} = U _{IH} = U _{CC} ; U _{ENB} = U _{IL} = 0 U _{EZA} = U _{IL} = 0; U _{ENB} = U _{IH} = U _{CC}	I _{occ}	-	1,0 20,0

8. Время задержки распространения при включении и выключении нс, от входов А0...А3, В0...В3 к выходам QА0...QА3, QВ0...QВ3, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ	t _{PHL} , t _{PLH}	- - -	115 23 20
при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 150 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L = 150 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L = 150 пФ	t _{PHL} , t _{PLH}	- - -	165 33 28
9. Время задержки распространения при переходе из третьего состояния в состояние низкого и высокого уровня, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 2,0 В, C _L = 150 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 4,5 В, C _L = 150 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 6,0 В, C _L = 150 пФ, R _L = 1кОм	t _{PZL} , t _{PZH}	- - - - - -	150 30 26 200 40 34
10. Время задержки распространения при переходе из состояния низкого и высокого уровня в третье состояние, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ, R _L = 1кОм	t _{PLZ} , t _{PHZ}	- - -	150 30 26
11. Входная емкость, пФ, при: U _{CC} = 0 В	C _I	-	10
12. Выходная емкость в состоянии «Выключено», пФ, при: U _{CC} = 4,5 В, U _{IL} = 0 В, U _{IH} = U _{CC}	C _{OZ}	-	20

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото г.

серебро г.

в том числе:

золото г/мм

на 24 выводах длиной мм.

Цветных металлов не содержится

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Нарботка микросхем до отказа T_n в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых

ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более (65+5) °С не менее 100000ч., а в облегченном режиме: при U_{CC} = 5В ± 10% - не менее 120000ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости (T_{Cγ}) при γ = 99% при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных, - в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.431200.424-17ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхему.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1564АП4ТЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.424-17ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____ Место для штампа ПЗ _____

Место для штампа « Перепроверка произведена _____ »
(дата)

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____ Место для штампа ПЗ _____

Цена договорная

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): 2-10; 22-10; 4-20; 24-10.

Остальные указания по эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.424 ТУ